本校專利案號：

**個人資料提供同意書**

國立中正大學（以下簡稱本校）為執行業務，依本同意書說明將如何處理本表單所蒐集到的個人資料。當您勾選「我同意」並簽署本同意書時，表示您已閱讀、瞭解並同意接受本同意書之所有內容及其後修改變更規定。若您尚未成年，應於您的法定代理人閱讀、瞭解並同意本同意書之所有內容及其後修改變更規定後，方得使用本服務，並遵守以下所有規範：

**一、蒐集個人資料之目的**

1.本校為**專利申請及維護相關業務**需蒐集您的個人資料。

2.當您提供的個人資料使用方式與當初本校蒐集的目的不同時，我們會在使用前先徵求您的書面同意，您可以拒絕向本校提供個人資料，但您可能因此喪失您的權益。

3.本校利用您的個人資料期間即日起30年內(各表單視實際狀況自行調整)，利用地區為台灣地區。

**二、基本資料之蒐集、更新及保管**

1.本校蒐集您的個人資料在中華民國「個人資料保護法」與相關法令之規範下蒐集、處理及利用您的個人資料。

2.本校因執行業務所蒐集您的個人資料包括姓名、國籍、身份證字號、服務機關、聯絡電話、地址、E-Mail等。

3.請於申請時提供您本人正確、最新及完整的個人資料。若您提供錯誤、不實、過時或不完整或具誤導性的資料，您將損失相關權益。

4.若您的個人資料有任何異動，請主動向本校申請更正，使其保持正確、最新及完整。

5.您可依中華民國「個人資料保護法」第3條規定，就您的個人資料行使以下權利：(1)查詢或請求閱覽。(2)請求製給複製本。(3)請求補充或更正。(4)請求停止蒐集、處理及利用。(5)請求刪求。

但因本校執行法定職務或法定義務等業務所必須者，本校得依法拒絕之。若您欲執行上述權利時，請與本項業務個人資料保護聯絡窗口聯繫05-27204011＃16500～16504。若因您行使上述權利，而導致權益受損時，本校將不負相關賠償責任。

**三、基本資料之保密**

您提供之資料依個人資料保護法受到保護及規範。本校如違反「個人資料保護法」規定或因天災、事變或其他不可抗力所致者，致您的個人資料被竊取、洩漏、竄改、遭其他侵害者，本校將於查明後以電話、信函、電子郵件或網站公告等方法，擇適當方式通知您。

**四、同意書之效力**

1.當您勾選「我同意」並簽署本同意書時，即表示您已閱讀、瞭解並同意本同意書之所有內容，您如不同意本同意書條款時，本校得隨時終止對您所提供之所有權益或服務。

2.本校保留隨時修改本同意書規範之權利，本校將於修改規範時，於本校網頁(站)公告修改之事實，不另作個別通知。如果您不同意修改的內容，請勿繼續接受本服務。否則將視為您已同意並接受本同意書該等增訂或修改內容之拘束。

3.您自本同意書取得的任何建議或資訊，無論是書面或口頭形式，除非本同意書條款有明確規定，均不構成本同意條款以外之任何保證。

**五、準據法與管轄法院**

本同意書之解釋與適用，以及本同意書有關之爭議，均應依中華民國法律予以處理，並以臺灣嘉義地方法院為管轄法院。

**□我已閱讀並接受上述同意書內容。 當事人簽名 (請親簽) 年 月 日**

**\*若當事人未成年，須經法定代理人簽名同意。 法定代理人簽名 (請親簽) 年 月 日**

**國立中正大學研究成果專利申請表**

# **National Chung Cheng University Invention Disclosure Form**

 本校案號：

 （Docket Number）

申請日期：

(Application Date)

◼ 請勾選申請國別 (可複選)：□中華民國 (R.O.C.)

□美國 (U.S.A.)

□日本 (Japan)

□中華人民共和國 (P.R.O.C.) – 信託發明人，經費自籌

□其他 (Other)：

◼ 發明人建議國外案優先順序 (List of priority):

一、發明人相關資訊

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 發明人Inventors | 1 | 姓名(代表人)Name(Proj. Leader) | (中 文)  | 國 籍 |  |
| (English)  | Citizenship |  |
| 身份證字號(ID No) | 服務機關 |  |
| Work Place |  |
| 身份別 | **任職單位：** **\*代表人必需為本校教師** |
| 電子郵件信箱E-mail |  | 電話及傳真Tel.& Fax | (T)  |
| (F)  |
| 永 久 地 址 | (中 文)  |
| Home Address | (English)  |
| 2 | 姓 名Name | (中 文)  | 國 籍 |  |
| (English)  | Citizenship |  |
| 身份證字號(ID No) | 服務機關 |  |
| Work Place |  |
| 身份別 | ⬜ 本校教師 單位名稱： ⬜ 本校學生 單位名稱： ⬜ 非本校之專利發明人 單位名稱：  |
| 電子郵件信箱E-mail |  | 電話及傳真Tel.& Fax. | (T)  |
| (F)  |
| 永久地址 | (中 文)  |
| Home Address | (English)  |
| 3 | 姓 名Name | (中 文)  | 國 籍 |  |
| (English)  | Citizenship |  |
| 身份證字號(ID No) | 服務機關 |  |
| Work Place |  |
| 身份別 | ⬜ 本校教師 單位名稱： ⬜ 本校學生 單位名稱： ⬜ 非本校之專利發明人 單位名稱：  |
| 電子郵件信箱E-mail |  | 電話及傳真Tel.& Fax | (T)  |
| (F)  |
| 永久地址 | (中 文)  |
| Home Address | (English)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 發明所屬資助計畫Sponsoring Project | 計畫名稱 | (若無則填「無」) |
| Title of Project |  |
| 計畫編號Project Number |  | 資助期間Time Period |  |
| 資助單位 |  |
| Sponsor |  |
| 計畫類型 | □ 國科會一般專題研究 □ 國科會產學計畫 □ 經濟部科專計畫 □ 企業產學合作計畫 □ 其他： |
| 3. 本發明是否已公開?Is the Invention Disclosed to the Public? | **□ 已公開發表(Yes)** 請註明發表之時間及場所(Please show the date and location) 時 間(date)：  場所(location)： **公開之目的 (請在適當空格內勾選) (The purpose of disclosure)**□ 學術刊物發表(Publication) 期刊名稱： □ 學術研討會發表(Symposium) 研討會名稱： □ 展覽(Exhibition) 展覽名稱： □ 其他(Other)□ 內容是學位論文一部份，口試日期： **□ 尚未公開發表(No)** 尚未公開發表，原因：  預計公開發表，發表日期： 請述明發表場合：  (Please indicate the anticipated disclosure date)* 為維持申請專利內容之新穎性，請勿在申請前，發表相關內容之論文。若已先行發表，請檢附已發表之相關文獻，並註明其發表日期及與專利內容之相關程度。按本國專利法規定，新穎性優惠期為12個月，即發明必須在刊物發表後12個月內提出專利申請，否則即喪失新穎性。

For the purpose of patent application (to maintain the novelty of your findings), please do not publish any of your invention before application. If you have already revealed part of them to the public, please attach your publications and write down the date and their relevance to your current invention disclosure. According to the patent regulations of ROC., the grace period of novelty is 12 months, i.e., the invention MUST be applied to the TIPO within a period of 12 months after its first disclosure in order to maintain its novelty in patentability. |

二、發明技術相關資訊

|  |  |
| --- | --- |
| 1.專利申請名稱Title of Invention | (中 文) |
| (English) |
| 2.專利類別The Patent Type | □ 發明(Invention) □ 新型(New model)  |
| 3.申請國家及理由詳述The Applied Countries and Reasons | □ 中華民國 Taiwan R.O.C. | 理 由Reason |  |
| □ 美國 U.S.A. | 理 由Reason |  |
| □ 日本 Japan | 理 由Reason |  |
| □ 其他地區 Other area | 國家名稱Country |  | 理 由Reason |  |
| 國家名稱Country |  | 理 由Reason |  |
| 4.相關先前技術調查情形The relevant technologies | 1 | 已檢索之資料(Patent Index)：關鍵字(Keyword)：資料庫(Database)： |
| 2 | 相類似技術或已發表之文獻 (The similar technology or literature)： |
| 5.本發明之特色The Advantages of the Invention | 1 | 與既有技術之比較(In comparison to the current technology)： |
| 2 | 本發明之特點(The advantages of the invention)： |
| 6.本發明可能應用的範圍Applicable fields of the Invention | 1 | 可能有興趣的授權對象(Potential Licensees)： |
| 2 | 本發明適用的產業類別(Applicable industries)： |
| 3 | 可能應用的產品 (Applicable products)： |
| 7.本發明中文摘要(Description of the invention in Chinese) **(必填)**： |
| 8.本發明英文摘要(Description of the invention in English)**(required)**： |
| 9.發明或創作背景(Background of the invention)：(即目前技術水平，本發明或創作所欲解決之問題及其技術範疇)(請詳加敘述，以利審查委員判斷及專利師撰寫說明書) |
| 10.發明或創作說明(Illustration)：(應載明有關之先前技術，發明或創作之目的、技術內容、較佳實施利、特點及功效，使熟習該項技術者能了解內容並可據以實施)(請詳加敘述，以利審查委員判斷及專利師撰寫說明書) |
| 11.申請專利範圍(Claim)：(即claims，惟在撰寫申請專利範圍前，請先考慮其(1)新穎性 (2)進步性 (3)實用性之組成、配方、製程、條件等並以條列方式說明之)(請詳加敘述，以利審查委員判斷及專利師撰寫說明書) |
| 12.圖式(Diagram)：(請詳加敘述，以利審查委員判斷及專利師撰寫說明書) |

三、發明人簽章

發明人： (簽章) 日期：

發明人： (簽章) 日期：

發明人： (簽章) 日期：

(填畢，請將此表及其他有關發明的輔助資料1式1份，以及「個人資料提供同意書」請每位發明人各自填1份，同時交給研究發展處，謝謝！)